最　高　行　政　法　院　判　決

110年度上字第398號

上　訴　人　頎邦科技股份有限公司

代　表　人　吳非艱
訴訟代理人　李宗德　律師
　　蔡毓貞　律師
　　劉昱劭　律師
複 代理 人　施志寬　律師
被 上訴 人　經濟部智慧財產局

代　表　人　洪淑敏
參　加　人　易華電子股份有限公司

代　表　人　黃嘉能
訴訟代理人　黃耀霆

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國110年3月4日智慧財產法院109年度行專訴字第40號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主　文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理　由

一、事實概要：緣上訴人前於民國105年3月17日以「線路基板圖案化製程及線路基板」向被上訴人申請發明專利，申請專利範圍共15項，經被上訴人編為第105108350號審查號審查後，於106年6月13日核准專利，並於106年8月11日公告發給發明第0000000號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人於108年1月30日以系爭專利違反專利法第26條第1項及第22條第2項規定，對之提起舉發。案經被上訴人審查，以108年12月

19日（108）智專三（一）04273字第10821207370號專利舉發審定書為「請求項1、8至10舉發成立，應予撤銷」、「請求項2至7、11至15舉發不成立」之處分（下稱原處分）。上訴人不服，就原處分關於舉發成立部分，循序提起行政訴訟（參加人就原處分關於舉發不成立部分，另循序提起行政訴訟，另經原審以109年度行專訴字第38號案件審理），並聲明：訴願決定及原處分中關於「請求項1、8至10舉發成立，應予撤銷」部分均撤銷，嗣經智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院，下稱原審）以109年度行專訴字第40號行政判決（下稱原判決）駁回其訴後，提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人於原審之答辯，均引用原判決所載。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠系爭專利核准公告之申請專利範圍共計15項，其中請求項1及10為獨立項，其餘均為附屬項，其中，請求項1至9為依附請求項1之附屬項，請求項11至15為依附請求項10之附屬項。依證據1第2圖(a)及第5頁第19至20行記載「如第2圖(a)所示，在聚醯亞胺膜1上形成鎳/鉻合金的金屬化層3，在其上以鍍銅形成金屬層4」，證據1已揭露系爭專利請求項1「一種線路基板圖案化製程，其包含：提供一待圖案化線路基板，該待圖案化線路基板具有一底板、一結合層及一線路層，該結合層位於該底板及該線路層之間」之技術特徵。㈡依證據1第2圖(a)、(b)及說明書第5頁第19行至第6頁第2行記載內容所示，證據1所述在金屬層4的表面形成以蝕刻形成電路圖案用的光阻5，且由證據1第2圖(a)可知該光阻5為經過圖案化之光阻層，之後使用氯化銅、氯化鐵溶液等蝕刻露出於光阻開口部的金屬層4及金屬化層3以形成電路圖案已揭露系爭專利請求項1「形成一光阻層，該光阻層罩蓋該線路層；圖案化該光阻層，以形成複數個開口，該些開口顯露該線路層；圖案化該線路層，以該光阻層為遮罩，移除被該些開口顯露的

該線路層，使該線路層形成複數個線路，相鄰的兩個該線路之間具有一第一槽，該第一槽顯露該結合層」之技術特徵。㈢依證據1第2圖(b)、(c)及說明書第6頁第3至11行記載內容所示，即相當於系爭專利請求項1「圖案化該結合層，……移除被該些第一槽顯露且未嵌入該活化層的該結合層，使位於該些線路下方的該結合層形成複數個第一承載部，相鄰的兩個該第一承載部之間具有一第二槽」之技術特徵。依證據1第2圖(c)、(d)及說明書第5頁第22至23行、第6頁第9至13行、第17至20行記載內容所示，即相當於系爭專利請求項1「以及圖案化該底板，以該些第一承載部為遮罩，移除被該些第二槽顯露的……，使位於該些第一承載部下方的……形成複數個第二承載部，相鄰的兩個該第二承載部之間具有一第三槽，該第三槽顯露該未活化層」之技術特徵。㈣證據1與系爭專利請求項1相較，二者差異為：證據1係以光阻為遮罩進行圖案化金屬層、金屬化層後，再移除光阻，而系爭專利請求項1係以光阻為遮罩進行圖案化線路層後，即移除光阻層，以線路層為遮罩進行圖案化結合層，二者步驟順序有差異。此外，證據1雖揭露於聚醯亞胺膜在形成金屬化層之際，在產生聚醯亞胺膜之表面上造成表面變質層2，惟證據1並未直接揭露聚醯亞胺底板經由一活化處理而形成一活化層及一未活化層之技術特徵，故亦未直接揭露「部分的該結合層嵌入該活化層中，使得嵌有該結合層的該活化層形成為一混合層」及「該第二槽顯露該混合層……移除被該些第二槽顯露的該混合層，使位於該些第一承載部下方的該混合層形成複數個第二承載部」之技術特徵。㈤在濕式蝕刻領域，均係利用化學蝕刻之選擇性，選擇特定蝕刻液來蝕刻特定材料，用以圖案化線路基板，且因特定蝕刻液並不會與蝕刻目標以外的材料進行反應，故蝕刻步驟順序之改變，僅係系爭專利申請日前濕式蝕刻領域普遍使用的資訊及經驗法則所瞭解的事項，應屬通常知識。證據1係揭露「圖案化該線路層—圖案化該結合層—移除該光阻層」之步驟順序，系爭專利

請求項1則係採取「圖案化該線路層—移除該光阻層—圖案化該結合層」之步驟順序，固有所不同，惟在濕式蝕刻領域，均係利用化學蝕刻之選擇性，選擇特定蝕刻液來蝕刻特定材料，用以圖案化線路基板，且因特定蝕刻液並不會與蝕刻目標以外的材料進行反應，已如前述，故蝕刻步驟順序之改變，僅係系爭專利申請日前濕式蝕刻領域之通常知識，因此，將證據1之「圖案化該線路層—圖案化該結合層—移除該光阻層」之步驟順序，變更為系爭專利請求項1之「圖案化該線路層—移除該光阻層—圖案化該結合層」，僅係通常知識之簡單變更，且該技術特徵之功效係通常知識所能預期。㈥依丙證5所載內容，已明確揭露活化處理的聚醯亞胺底板表面可以使濺鍍金屬粒子之附著力更佳為系爭專利申請前之通常知識，該發明所屬技術領域中具有通常知識者應可瞭解此係因活化處理將使聚醯亞胺底板表面的分子鍵結被切斷而活化，造成粒子吸附力增加，則活化處理之聚醯亞胺底板表面自然會吸附雜質，惟聚醯亞胺底板表面如吸附雜質，必然影響接著劑於底板表面之附著力，進而影響線路基板與玻璃基板之結合強度，如去除經活化處理之表面，而顯露未活化層，即可避免吸附雜質，並達成提高結合強度之功效，是系爭專利所產生之功效，為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所可預期，故參酌系爭專利申請時之通常知識1、2，證據1足以證明系爭專利請求項1不具進步性。㈦經比對證據1與系爭專利請求項1僅有蝕刻步驟順序不同之差異，或未直接揭露聚醯亞胺底板經由一活化處理而形成一活化層及一未活化層之技術特徵，故亦未直接揭露「部分的該結合層嵌入該活化層中，使得嵌有該結合層的該活化層形成為一混合層」及「該第二槽顯露該混合層……移除被該些第二槽顯露的該混合層，使位於該些第一承載部下方的該混合層形成複數個第二承載部」之技術特徵，然證據2已揭露系爭專利請求項1「底板具有一活化層及一未活化層，底板經由一活化處理而形成一活化層」及「部分的該結合層嵌入該活化層

中，使得嵌有該結合層的該活化層形成為一混合層」之技術特徵，證據5則揭露系爭專利請求項1「圖案化該線路層—移除該光阻層—圖案化該結合層」之步驟順序，且蝕刻步驟順序或底板活化處理均係通常知識，均如前述。另由證據1、2、5說明書上述段落所載內容可知，證據1、2、5均屬於半導體封裝用軟性電路板之技術領域，具有技術領域之關聯性，且均係在絕緣膜上形成電路圖案，以作為封裝用之軟性電路基板，電路基板結構之功能作用相同，具有功能或作用之共通性，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機將證據1之軟性電路板製程所使用的聚醯亞胺基板，使用證據2揭露之經過電漿活化之聚醯亞胺基板，以確保聚醯亞胺基板與第一金屬層的結合力，並有動機參考證據5所揭露之蝕刻步驟順序，而輕易完成系爭專利請求項1之發明，故證據1、2、5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。㈧在線路基板圖案化製程中，通常須先對聚醯亞胺底板進行活化處理，以增加金屬及聚醯亞胺底板間的接著，確係屬系爭專利申請時之通常知識，業如前述。況系爭專利自承之先前技術亦記載「在習知的線路基板製程中，會先活化處理一底板的一表面，以利於後續製程中形成線路」，因此，就證據1所揭露以聚醯亞胺膜上形成鎳鉻合金的金屬化層並在其上以鍍銅形成銅箔層構成之電路圖案之製造方法，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，通常即會先活化處理聚醯亞胺膜之一表面，以提高聚醯亞胺膜與鎳鉻金屬化層間之結合力，而證據1之聚醯亞胺膜之表面經過活化處理形成活化層後，使用濺鍍法在聚醯亞胺膜之表面上形成鎳/鉻合金之金屬化層3（相當於系爭專利之結合層）時，因部分金屬化層3嵌入聚醯亞胺膜之活化層而產生表面變質層2，即相當於系爭專利請求項10之「其中該混合層是由該底板之一活化層與部分嵌入該活化層之一結合層所形成」之技術特徵。㈨證據1與通常知識1、2之組合、證據1、2之組合、證據1、5與通常知識2之組合、證據1、2、5之組合均足以證明系爭專利請

求項1、8、9不具進步性，證據1與通常知識1、2之組合、證據1、2之組合、證據1、6與通常知識2之組合、證據1、2、6之組合均足以證明系爭專利請求項10不具進步性等語，判決駁回上訴人在原審之訴。

四、本院經核原判決並無違誤。茲就上訴理由再予補充論述如下：

㈠按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利申請日為105年3月17日，經被上訴人審查後於106年6月13日審定准予專利，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時之100年12月21日修正公布、102年1月1日施行之專利法(即核准時專利法)為斷。按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為核准時專利法第21條及第22條第1項前段所明定。又發明如「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，不得取得專利，復為同法第22條第2項所明定。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭專利法規定者，依法得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發成立之處分。

㈡系爭專利之線路基板圖案化製程，於圖案化底板時，移除顯露的混合層，避免混合層吸附雜質而影響接著劑與線路基板之間的接合強度，而降低封裝構造良率。此外，另藉由等向性蝕刻所產生的側蝕槽S用以容置接著劑，進一步提高接著劑的附著力。系爭專利申請專利範圍共計15項，其中請求項1及10為獨立項，其餘均為附屬項。本件關於證據1與通常知識1、2之組合、證據1、2之組合、證據1、5與通常知識2之組合、證據1、2、5之組合均足以證明系爭專利請求項1、8、9不具進步性，證據1與通常知識1、2之組合、證據1、2之組合、證據1、6與通常知識2之組合、證據1、2、6之組合

均足以證明系爭專利請求項10不具進步性等情，業據原審一一論明，經核並無違經驗法則、論理法則或證據法則，亦無所適用之法規與該案應適用之法規違背，而有判決違背法令之情形。

㈢依證據1第2圖(c)、(d)及說明書第5頁第22至23行、第6頁第9至13行、第17至20行記載內容所示，證據1揭露於聚醯亞胺膜1在形成金屬化層3之際，產生表面變質層2，藉由溶解電路圖案外周的金屬化層3後，因露出電路圖案間的聚醯亞胺膜1表面係殘留含有原為金屬化層之金屬成分的表面變質層2等情，為原審依調查證據之辯論結果所認定之事實，原判決因認：證據1揭露於聚醯亞胺膜1在形成金屬化層3之際，產生表面變質層2，藉由溶解電路圖案外周的金屬化層3後，因露出電路圖案間的聚醯亞胺膜1表面係殘留含有原為金屬化層之金屬成分的表面變質層2，為得到絕緣可靠性，即以強力蝕刻液將聚醯亞胺膜1表面含有金屬成分的表面變質層2厚厚地去除，使得經蝕刻之聚醯亞胺膜1已經不具有表面變質層2，而顯露為原始狀態之聚醯亞胺膜1等情，並無不合，核與論理法則無違。可知，原判決據此認定證據1中所顯露之「原始狀態之聚醯亞胺膜1」即為經蝕刻而不具有表面變質層之聚醯亞胺膜。而上訴人所指「沒有去除電路外周部的金屬化層的原始狀態」，係關於證據1圖2(b)之記載內容，與證據1圖2(c)、(d)無關。上訴意旨以：證據1說明書中僅有一處提及「原始狀態」，是證據1中僅有原始狀態之金屬化層，原判決在解釋證據1時，自應以證據1記載之內容為準，且圖2之製造步驟為不可分的一系列流程，圖2(b)之說明乃圖2(c)、(d)的前提基礎，當可作為證據1對原始狀態之解釋及定義。原判決所稱「原始狀態」的聚醯亞胺膜，或參加人稱「呈現原本之狀態」的聚醯亞胺膜，皆缺乏具體內容，難以確知所指為何。原判決並無事實基礎，違背論理法則，而有不適用行政訴訟法第189條第1項前段之違法云云，並無可採。

㈣所謂判決理由矛盾，指判決所載理由前後牴觸或判決主文與理由不符之情形而言。承前關於「即以強力蝕刻液將聚醯亞胺膜1表面含有金屬成分的表面變質層2厚厚地去除，使得經蝕刻之聚醯亞胺膜1已經不具有表面變質層2，而顯露為原始狀態之聚醯亞胺膜1……」部分，原判決認相當於系爭專利請求項1「……該第三槽顯露該未活化層」之技術特徵。可知，原判決係基於證據1未揭示對聚醯亞胺膜1進行活化處理，因此原始狀態之聚醯亞胺膜1相對於經過活化處理之聚醯亞胺膜，即屬於未活化狀態，而與系爭專利未活化層實質相同而可對應。原審經比對證據1與系爭專利請求項1之差異所在，論明：證據1係以光阻為遮罩進行圖案化金屬層、金屬化層後，再移除光阻，而系爭專利請求項1係以光阻為遮罩進行圖案化線路層後，即移除光阻層，以線路層為遮罩進行圖案化結合層，二者步驟順序有差異。此外，證據1雖揭露於聚醯亞胺膜在形成金屬化層之際，在產生聚醯亞胺膜之表面上造成表面變質層2，惟證據1並未直接揭露聚醯亞胺底板經由一活化處理而形成一活化層及一未活化層之技術特徵，故亦未直接揭露「部分的該結合層嵌入該活化層中，使得嵌有該結合層的該活化層形成為一混合層」及「該第二槽顯露該混合層……移除被該些第二槽顯露的該混合層，使位於該些第一承載部下方的該混合層形成複數個第二承載部」之技術特徵等情。可知，原判決係認由於證據1未揭示「活化處理」，故證據1並未同時揭露活化處理形成之「活化層」及「未活化層」，未經活化處理之聚醯亞胺膜，本質上即為未活化層，故原判決僅認證據1之聚醯亞胺膜可對應系爭專利之「未活化層」，而與活化層或混合層相關之技術特徵，原判決則認定證據1未直接揭露，並無理由矛盾之違背法令。上訴意旨以：原判決認定證據1已具體對應系爭專利「顯露未活化層」之技術特徵，卻又以「證據1並未直接揭露聚醯亞胺底板經由一活化處理而形成一活化層及一未活化層之技術特徵」，原判決對證據1是否揭露系爭專利「顯露

未活化層」之特徵，於不同段落為相反之認定，有理由矛盾之違背法令云云，委無可採。

㈤依原審確定之事實，上訴人在系爭專利申請審查時曾提出申復說明書記載「線路131、第一承載部121、圖案化底板110’之第二承載部114及未活化層112由上往下依序排列以形成線路基板100’」、「請參閱本案之第3及4圖，本案之底板110經活化處理形成活化層111及未活化層112，由於結合層120形成於活化層111上時會部分嵌入活化層111中，因此活化層111及嵌入的結合層112形成混合層113，其中混合層113經圖案化製程後形成第二承載部114，而第二承載部114及未活化層112構成本案之圖案化底板110’（如第11圖所示）」等情，原判決因認：已明確表示系爭專利之線路基板結構由上往下依序為「線路、第一承載部、圖案化底板之第二承載部及未活化層」，圖案化底板之第二承載部即經圖案化之混合層等情，核無不合。原審再依系爭專利請求項1之記載（原判決第13頁第24行至第14頁第5行）論明：可知嵌有該結合層的該活化層係形成一混合層，圖案化之混合層則形成第二承載部，第二承載部之間會顯露未活化層，換言之，系爭專利請求項1已明確界定圖案化混合層而形成第二承載部後，即會顯露未活化層等情，詳論其認定之依據及得心證之理由，核無判決違背法令情事。再者，原判決僅認定「無從依甲證4即認定乾式製程或其他濕式製程之混合層內存在未嵌有該結合層的剩餘活化層」，並未認定不存在未遭結合層嵌入的「剩餘活化層」。故上訴人主張：系爭專利說明書與圖式未記載活化層必定「全部」被結合層嵌入而無「剩餘活化層」之限制條件，丙證2也只是重申系爭專利說明書之描述，無涉「剩餘活化層」之解釋，系爭專利之解釋不該具有此等限制條件，原判決違反禁止讀入原則，有判決不適用法規之違法云云，係持其一己主觀之見解，就原審已詳予論斷之事項再予爭執，並非可採。

㈥再查，原審法院已就其調查之證據，本於所得之心證，依甲證4第2頁第1至4行之記載，認定甲證4對於「鎳—奈米膜（相當系爭專利之混合層）」之形成，僅記載採用DMAB還原溶液將摻入PAA的鎳二價離子快速化學還原之濕式製程形成，並未記載任何濺鍍等乾式製程形成鎳—奈米膜之技術手段，因此尚無從依甲證4即認定乾式製程或其他濕式製程之混合層內存在未嵌有該結合層的剩餘活化層等情，核與論理法則及經驗法則無違，難謂有判決不適用法規之違法。上訴意旨以：甲證4性質為輔助證據或補強證據，係證明證據1中「即使厚厚地去除表面變質層也會有未變質的剩餘活化層」之待證事實，甲證4已證明對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，乾式製程、濕式製程或乾濕式製程併用之選擇為系爭專利申請前的通常知識，原判決不採納甲證4之認定，完全沒有任何理論基礎，違反論理法則，有適用法規不當之違法云云，無非就原審法院取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。

㈦上訴意旨另主張：原判決依證據1中「電路密著性」一詞認定其隱含具有電路密著性之結構或組成。姑不論何謂「具有電路密著性之結構或組成」，依證據1中關於「電路密著性」的記載，係指在電路圖案表面施行金屬鍍覆時，鍍液滲入電路圖案下側被溶解的絕緣膜(即聚醯亞胺膜)與電路圖案之間所造成的問題，故使表面變質層從電路圖案的下側外周部以5微米以下的寬度剩餘殘留著。證據1並未在聚醯亞胺膜和電路圖案間隱含任何結構或組成，判決理由與證據1存在明顯歧異。原判決參酌通常知識2認定證據1的底板表面隱含活化層，違反論理法則，有不適用行政訴訟法第189條第1項之違法云云。但查，依證據1第5頁第10至14行之記載（原判決第17頁第25行至第18頁第4行），原判決論明：所述「電路密著性」即隱含聚醯亞胺膜和2層材料之電路圖案間具有電路密著性之結構或組成，且依丙證5之內容可知，在線路基板圖案化製程中，先對聚醯亞胺（PI）底板進行活化前處

理，係屬於系爭專利申請時之通常知識，參酌系爭專利自承之先前技術亦記載「在習知的線路基板製程中，會先活化處理一底板的一表面，以利於後續製程中形成線路」，因此，就證據1所揭露以聚醯亞胺膜上形成鎳鉻合金的金屬化層並在其上以鍍銅形成銅箔層構成之電路圖案之製造方法，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，通常即會先活化處理聚醯亞胺膜之一表面，以提高聚醯亞胺膜與鎳鉻金屬化層間之結合力，而相當於系爭專利請求項1「底板經由一活化處理而形成一活化層及一未活化層」之技術特徵等情，並無違反論理法則及經驗法則。從而，原判決僅在說明聚醯亞胺膜和2層材料之電路圖案間具電路密著性之需求，系爭專利所屬技術領域中具通常知識者在依據通常知識2或丙證5，自會對證據1之聚醯亞胺膜進行活化處理，以提高聚醯亞胺膜與鎳鉻金屬化層間之結合力，確保電路密著性。故上訴論旨，委無可採。

㈧依專利審查基準規定，一般知識，指該發明所屬技術領域中已知的知識，包括工具書或教科書所載之周知（well-known）的知識，亦包括普遍使用（commonly used）的資訊及從經驗法則所瞭解的事項。普通技能，指執行例行工作、實驗的普通能力。一般知識及普通技能，簡稱「通常知識」。可知，專利審查基準僅規定教科書或工具書內所載之資訊即可認定為該所屬技術領域之一般知識，蓋因教科書或工具書為通常知識者過往學習使用之書籍，無須花費相當精力檢索，隨時可查詢到之資訊，可作為代表所屬技術領域一般知識範圍。查上訴人於舉發階段另主張系爭專利說明書所載先前技術，即「在習知的線路基板製程中，會先活化處理一底板的一表面，以利於後續製程中形成線路」係屬申請時之通常知識2。嗣經原審行使闡明權後，另提出丙證5之台灣電路板協會公開發行之「軟性電路板材料全書」參考書以為佐證。原判決依丙證5之內容（原判決第17頁第6行至第20行）可知「在線路基板圖案化製程中，先對聚醯亞胺（PI）底板進行

活化前處理，用以增加金屬和PI膜之間的接著」，屬於系爭專利申請時之通常知識，且專利審查基準並未規定通常知識須為我國通常知識者所能實施。故上訴人主張：丙證5於西元2007年公開時，所揭示之內容僅能為具備高度知識之專業技能者在國外實施，國內業者必須透過國外專家進行專有知識(know-how)的技術移轉始能實施，丙證5所記載活化處理並非系爭專利申請時之通常知識，丙證5應為先前技術。原判決認定丙證5所述內容為通常知識2，顯然違背論理法則，除了丙證5沒有其他證據，卻逕認系爭專利說明書「先前技術」所載內容為自承通常知識2，完全沒有任何論理基礎，有不適用行政訴訟法第189條第1項前段之違法云云，均無可採。

㈨綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。又「最高行政法院之判決不經言詞辯論為之。但有下列情形之一者，得依職權或依聲請行言詞辯論：二、涉及專門知識或特殊經驗法則，有以言詞說明之必要。」為行政訴訟法第253條第1項第2款所明定。本件縱涉及專門知識，且影響上訴人之權利，然當事人就相關專門知識均已具狀說明，故本件事證已明，且經審酌本件訴訟之情節，本院認無行言詞辯論之必要，併此敘明。

五、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

中　華　民　國　111　年　12　月　29　日

最高行政法院第三庭

審判長法　官　胡　方　新

法　官　蕭　惠　芳

法　官　曹　瑞　卿

法　官　梁　哲　瑋

法　官　林　惠　瑜

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　　華　　民　　國　　111　　年　　12　　月　　29　　日

書記官　林　郁　芳